



Cette image peut être téléchargée en haute et basse résolution en cliquant ici :

<https://publitekltd.sharepoint.com/:f/s/PublitekFTP/EgahO0XQozZMnYLNakj8PJsBbDBWNm4cx1R4qovhFYEww?e=fdlBvz>

Toshiba lance des MOSFET en carbure de silicium (SiC) de 3^{ème} génération avec des pertes de commutation réduites

Ces nouveaux composants à boîtier à 4 broches offrent les performances de commutation améliorées des MOSFET dans les applications industrielles

Düsseldorf, Allemagne, 14 Septembre 2023 – Toshiba Electronics Europe GmbH ("Toshiba") a lancé la série TWxxxZxxxC de dix MOSFET en carbure de silicium (SiC) basés sur sa technologie de troisième génération. Ils sont destinés à réduire les pertes dans une grande variété d'applications industrielles, notamment les alimentations à découpage pour les serveurs et les centres de données, les stations de recharge pour véhicules électriques (EV), les onduleurs photovoltaïques (PV) et les alimentations sans interruption (*uninterruptible power supplies*, UPS).

Les composants de la série TWxxxZxxxC sont les premiers produits SiC de Toshiba à être logés dans un boîtier TO-247-4L(X) doté d'une quatrième broche. Cela permet d'obtenir une connexion Kelvin de la borne source de signal pour le pilotage de la grille, réduisant ainsi les effets d'inductance parasites du fil de source interne et améliorant les performances de commutation à grande vitesse. La comparaison du TW045Z120C avec le TW045N120C existant de Toshiba (TO-247 à 3 broches) montre une amélioration de la perte à l'activation d'environ 40 %, tandis que la perte à la désactivation est améliorée d'environ 34 %.

La nouvelle série TWxxxZxxxC comprend cinq composants avec une valeur nominale drain-source (V_{DSS}) de 650 V et cinq autres composants évalués à 1200 V pour les applications à plus haute tension. La résistance drain-source typique ($R_{DS(ON)}$) est comprise entre 140 m Ω et 15 m Ω . Associé à de faibles valeurs de charge drain grille (Q_{GD}), cela permet de faibles pertes, même dans les applications à haute fréquence.

Les composants sont capables de fournir des courants de drain continus (I_D) allant jusqu'à 100 A.

Visitez le site Web de Toshiba pour plus d'informations :

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/mosfets/sic-mosfets.html>

Les livraisons de la nouvelle série de MOSFET SiC commencent aujourd'hui.

Toshiba continuera de contribuer à l'amélioration de l'efficacité et de la densité de puissance des équipements industriels en poursuivant le développement de sa gamme de produits.

###

À propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande variété de lecteurs de disques durs (*hard disk drive*, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour l'automobile, l'industrie, l'IoT, le contrôle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de l'entreprise comprend des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontrôleurs et des produits standard spécifiques à l'application (*application specific standard products*, ASSP), entre autres.

En outre, TEE propose également les cellules et modules de batterie SCiB™ de Toshiba à l'oxyde de lithium-titane (LTO) pour les applications les plus exigeantes et les substrats céramiques en nitrure de silicium (SiN) utilisés dans les modules semi-conducteurs de puissance, les onduleurs et les convertisseurs pour leurs caractéristiques de dissipation thermique et leur résistance.

TEE a son siège à Düsseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba à www.toshiba.semicon-storage.com, www.scib.jp/en et www.toshiba-tmat.co.jp/en/ pour plus d'informations sur la société et ses produits.

Contact pour publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0

Web : www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Contact presse :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0)7464 493526

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +49 (0) 4181 968098-13

Web : www.publitek.com

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com

Septembre 2023

Ref. 7492F